

Лаборатория Неорганической Кристаллохимии Кафедра Неорганической Химии, Химический Факультет МГУ

# Примеры применения порошковой рентгеновской дифракции. Сочетание с другими дифракционными методами.

Москва 2011. Курс для ФНМ МГУ группы.

#### 1. Рентгеновская дифракция для тонких пленок.

- 1.1 Дифракция на системе «тонкая пленка подложка».
- 1.2 Асимметричные геометрии съемки
- 1.3 Геометрия «скользящего пучка».
- 1.4 Полное внешнее отражение. Рефлектометрия.

#### 2. Малоугловое рассеяние РИ (МУРР, SAXS)

- 2.1 Дифракция на индивидуальной наночастице. Однородное приближение.
- 2.2 Система многих частиц. Межчастичная интерференция.
- 2.3 Некоторые подходы к анализу данных МУРР. Формула Гинье.
- 2.4 Малоугловой дифрактометр.

#### 3. Другие дифракционные методы для порошка.

- 3.1 Электронная дифракция
- 3.2 Электронная микроскопия высокого разрешения.

## 1.1 Дифракция на системе «тонкая пленка-подложка»

S

#### Особенности объектов

- Не «бесконечно поглощающие слои»
- Значительное текстурирование
- (эпитаксиальные пленки)
- Особенности для ρ(z).
- Аморфизация пленок





 $d_F = 0.46(2)$  мкм w(Anatase) = 91(1)% w(Rutile) = 9(1)%

# 1.2 Асимметричные геометрии съемки



# 1.3 Геометрия «скользящего пучка»



$$I_{S}^{F} = \sigma I_{P}^{0} \frac{1}{\mu_{F}} \frac{\sin(2\theta - \omega)}{\sin\omega + \sin(2\theta - \omega)} \left( 1 - e^{-\mu_{F}d_{F} \left( \frac{\sin\omega + \sin(2\theta - \omega)}{\sin\omega \sin(2\theta - \omega)} \right)} \right)$$

#### Проблема дефокуса вторичного пучка Зееман-Болин Брегг-Брентано детектор детектор расфокусировка источнин D 20 *θ* падения образец образец источник 5 детектор падения A зеркало Использование зеркал Геббеля источник Гебеля – стандарт для S D исследований тонких **2**0 в падения образец пленок

# 1.3 Геометрия «скользящего пучка»



геометрии скользящего пучка

# ГОСТ Р 8.968-2010

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ		
œ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ГОСТ Р 8.698— 2010
Государствен	ная система обеспечения измерений	а единства
РАЗМЕРНЫ І	Е ПАРАМЕТРЫ НАНО И ТОНКИХ ПЛЕНОК	ЧАСТИЦ
Методика вы малоугловог	полнения измерений с п о рентгеновского дифра	омощью ктометра
	Издание официальное	
<b>53 2</b> —2010/1095		
	Москва Стандартинформ 2010	

## 1.4 Полное внешнее отражение. Рефлектометрия.



$$n_2 \cos(\theta_2) = n_1 \cos(\theta_1)$$

Тогда для малых значений угла падения критический угол:

$$n_2 = \cos(\theta_c) \approx 1 - \frac{\theta_c^2}{2}$$

Чем это может помочь?

Как рассчитать показатель преломления?

$$n = 1 - \delta + i\beta = 1 - \frac{r_0 \lambda^2}{2\pi} n_e$$

 $r_0$  – боровский радиус,  $\lambda$  – длина волны,  $n_{\rm e}$  – концентрация электронов, а именно:

$$n_e = f \cdot n_a = (Z + f + i f) \cdot n_a = (Z + f + i f) \frac{N_a}{A} \rho$$

f – атомный фактор рассеяния, n<sub>a</sub> – концентрация атомов

$$\begin{cases} \delta = \frac{r_0 \lambda^2}{2\pi} \frac{N_a}{A} (Z + f^{\text{``}})\rho \\ \beta = \frac{r_0 \lambda^2}{2\pi} \frac{N_a}{A} f^{\text{``}}\rho \end{cases}$$

При допущении малости  $\beta$ :

$$\frac{r_0 \lambda^2}{\pi} (Z + f) \frac{N_a}{A} \rho = \theta_c^2$$

# 1.4 Осцилляции Киссига



Положение максимума порядка т:

# Закон Брегга как условие позитивной интерференции:

 $2d\sin\theta = m\lambda$ 

Закон Снелла:

$$n_2 \cos(\theta) = n_1 \cos(\theta_m)$$

#### Т.к. для малых углов:

$$n_2 = \cos(\theta_c) \approx 1 - \frac{\theta_c^2}{2}$$

$$\boldsymbol{\theta}^2 = \boldsymbol{\theta}_m^2 - \boldsymbol{\theta}_c^2$$

$$\theta_m^2 = \frac{m^2 \lambda^2}{4d^2} + \theta_c^2$$

$$d = \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\sqrt{\theta_{m+1}^2 - \theta_c^2} - \sqrt{\theta_m^2 - \theta_c^2}} \approx \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\theta_{m+1} - \theta_m}$$

To:

Для неидеальных («шероховатых») пленок:

$$R(s) = R_F(s) \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{isz} \frac{\partial \rho}{\partial z} dz \right|^2$$

Также возможна и дифракция на сверхрешетках:



#### В таких системах зачастую наблюдается суперпозиция осцилляций Киссига

# 2. Малоугловое рассеяние РИ.

# Small Angle X-Ray Scattering (SAXS)

- Упругое рассеяние РИ
- Диапазон углов 2*θ* = 0.1 3.5°
- Длины волн в лабораторных установках: 2.2 – 0.7 Å
- Характерные размеры
  неоднородностей 100 20 нм
- Исследование
  упорядоченных наносистем,
  полимеров, биологических
  объектов, неорганических
  наночастиц,



## 2.1 Дифракция на индивидуальной наночастице



Аналогичная задача для атома:



# 2.1 Однородное приближение



## 2.2 Система многих частиц



Тогда (для среднего числа частиц <N>):

$$I(s) = \langle N \rangle \left| F(s) \right|^2 \left\{ 1 - \frac{1}{v_1} \int_0^\infty \left[ 1 - P(r) \right] \frac{\sin sr}{sr} 4\pi r^2 dr \right\}$$

где:

$$s = 2\pi |\mathbf{q}| = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}, P(r) = \frac{p(r)}{v_1^2}, v_1 = \frac{V_0}{\langle N \rangle}$$

*p*(*r*) – усредненная по направлениям функция распределения частиц (вероятность обнаружить частицу на расстоянии *r* от данной)

### Для разбавленных систем ( $V_1$ велико):

 $I^{0}(s) = \langle N \rangle |F(s)|^{2}$  информация о рассеянии на отдельных частицах

# Для концентрированных систем (V<sub>1</sub> мало):

$$I(s) = I^{0}(s) - \langle N \rangle |F(s)|^{2} \frac{1}{v_{1}} \int_{0}^{\infty} \left[1 - P(r)\right] \frac{\sin sr}{sr} 4\pi r^{2} dr \quad \text{межчастичная интерференция}$$

### Следует работать с разбавленными системами!

Согласно ГОСТ 8.268-2010 расстояние между частицами должно не менее чем в 10 раз превосходить их линейные размеры (V<sub>1</sub>~1000V)

На качество данных критически влияет контраст:  $g(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) - \rho_s$ 

# 2.2 Межчастичная интерференция

### Упорядочение наночастиц.



Для упорядоченных систем межчастичная интерференция неизбежна и даже желательна (информация об упорядочении)

## В начальной области кривой рассеяния (формула Гинье):



#### Максимальный размер частицы можно определить по формуле



 $l_{m} = 2\pi \frac{\int_{0}^{1} \frac{I(s)}{I(0)} s ds}{\int_{0}^{\infty} \frac{I(s)}{I(0)} s^{2} ds}$  здесь максимальный размер – максимальный линейный размер внутри частицы!

Средний форм-фактор полидисперсной системы:

$$\left\langle F^{2}\left(s\right)\right\rangle = \int_{0}^{\infty} \left\langle F_{0}^{2}\left(s,R\right)\right\rangle m^{2}\left(R\right) D\left(R\right) dR$$

Здесь  $m^{2}(R)$  - функция V(R), D(R) - распределение по величине R,  $\left\langle F_{0}^{2}(s,R)\right\rangle, F_{0}(0,R) = 1$ 

Существуют два подхода к определению распределения D(R):

1. Предположение вида распределения с дальнейшим варьированием параметров

2. Расчет D(R) непосредственно из экспериментальных данных для известной формы частиц (ГОСТ 8.268-2010)

$$D(R) = \frac{Const}{R^2} \int_{0}^{\infty} \left[ s^4 I(s) - \lim_{s \to \infty} \left\{ s^4 I(s) \right\} \right] \left\{ \cos 2sR \left[ 1 - \frac{2}{\left( sR \right)^2} \right] - \frac{2\sin sR}{sR} \left[ 1 - \frac{1}{2\left( sR \right)^2} \right] \right\} ds \qquad \begin{array}{c} \mathbf{Д}_{\mathcal{I}}_{\mathcal{I$$

2.3 Первичная обработка данных МУРР

$$I_{\exp}(s) = (K(s) * I(s)) \times A(s) \times LPG$$

Необходима коррекция (ГОСТ 8.268-2010):

- На конечные размеры пучка (т.е. *K(s)*)
- На поглощение

$$I'(s) = I_{\exp}(s) \times \frac{I_P}{I_{\exp}(0)}$$

• На рассеяние на кювете без образца (но с дисперсионной средой)

$$I_{o \delta p}(s) = I'_{o \delta p + \kappa \iota o \beta e m a}(s) - I'_{\kappa \iota o \beta e m a}(s)$$

Только после учета этих факторов можно обрабатывать кривую рассеяния!

# 2.4 Малоугловой дифрактометр



- 1. Генератор
- 2. Источник
- 3. Фокусирющий монохроматор
- 4. Вакуумные щели

- 5. Вакуумный волновод
- б. Камера образца
- 7. Щелн образа
- 8. Образец

9. Z-	привод.
10.Д	вухружный гониометр
11. B	акуумный затвор
12. X	-Ү привод

- Вакуумный волновод
  Камера ловушки пучка
  2D детектор
- 16. Оптический столик



Существуют также приставки к обычным порошковым дифрактометрам



первичный электронный пучок

# Взаимодействие электронов с веществом намного сильнее, чем рентгеновских квантов!







# Определение межплоскостных расстояний

$$d_i = \frac{L\lambda}{r_i}$$

Определение базисных векторов

 $(h_1, k_1, l_1)$  и  $(h_2, k_2, l_2)$ 

$$\mathbf{g}_{hkl} = m\mathbf{g}_1 + n\mathbf{g}_2, (m, n) \in \mathbb{Z} \ \forall \mathbf{g}_{hkl}$$

#### Определение индекса зоны:

$$g_{t} = [g_{1} \times g_{2}] = \begin{vmatrix} \mathbf{a}^{*} & \mathbf{b}^{*} & \mathbf{c}^{*} \\ h_{1} & k_{1} & l_{1} \\ h_{2} & k_{2} & l_{2} \end{vmatrix}$$





Определение Лауэ-класса (всего 11)...



....а кристаллографических точечных групп 32





Pbam (55), a = 6.917 Å, b = 15.505 Å, c = 3.454 Å

Ti<sub>9</sub>Se<sub>2</sub> [001]

# 3.2 Электронная микроскопия высокого разрешения



# 3.2 Электронная микроскопия высокого разрешения



- 1. Дифракционные методы применимы к исследованию практически любых объектов в конденсированном состоянии.
- Тонкие пленки обычно изучают при малых углах падения первичного пучка: при больших углах рассеяния это позволяет увеличить интенсивность, при малых – исследовать эффекты полного внешнего отражения и дифракции на сверхрешетках.
- 3. Для дисперсных систем рассеяние в области малых углов несет в себе информацию о размерах, форме и упорядочении частиц.
- 4. Дифракционные методы не ограничиваются XRD/SAXS/XRR методы ED и HREM являются одними из наиболее мощных в исследовании вещества на микроуровне. При этом в методе HREM дифрагировавшее излучение вновь интерферирует – «Фурье синтез» непосредственно в приборе.